

15p - YN - 12

抵抗加熱 SBN 単結晶引上げにおけるルツボ下部冷却の効果
Effects of crucible-base cooling in SBN crystal pulling by using resistance heating

NTT光エレクトロニクス研究所 ○久保田英志、山崎裕基、八木生剛、小野道雄、佐浦正弘、今井鉄之
NTT Opto-electronics Laboratories E.Kubota, H.Yamazaki, S.Yagi, M.Ono, M.Sasaura and T.Imai
kubota@iba.iec.ntt.jp

【はじめに】抵抗加熱により低温度勾配下で育成した Ce ドープ SBN 単結晶は優れたフォトリラクティプ特性を示す^{1, 2)}。ただし、サイズの点で実用上の問題がある。今回、直径 30mm 以上の長尺結晶育成をねらいとし、ルツボ下部冷却の効果を検討したので報告する。【実験と結果】2ゾーンの抵抗加熱炉を用い、調和浴融組成 (SBN61) の融液より C 軸方位の結晶を引き上げた。冷却は白金ルツボ下部中心に空気ガスを吹き付けることにより行った。図1は育成した 30~45mm 径単結晶である。成長界面形状は、冷却なしに比べて凹状である。これは平均または液側に凹であったが、冷却した場合は液側に凹であった。また、終端面も凸状で軸中心の冷却なしに比べて凹状である。長尺化への有効性が確認できた。一方、ガス冷却なしの結晶では融液温度変動が小さく、ガス冷却なしの結晶で観察される不規則型 (間隔がランダム) のストリエーション (図2) は消失し、薄色で観察される規則型 (間隔が一定) のみが存在しており、ストリエーション低減への有効性も確認された。

1, 2) '97秋応物学会予稿 5a-ZE-2, 5p-H-8



図1

図2

15p - YN - 13

Growth and characterization of new UV laser crystal Ce:BaLiF₆

S.L.Baldochi, K.Shimamura, Namujilatu, T.Fukuda

Institute for Materials Research, Tohoku University

E-mail : baldochi@lexus.imr.tohoku.ac.jp

Since the discovery that cerium-doped colquirite as LiSrAlF₆ and LiCaAlF₆ offer means of generating tunable ultraviolet radiation, interest in direct solid state laser sources for this purpose has been re-kindled. Very few UV laser materials proper for direct pumping are known. Recently, Dubinskii et al.¹, have reported the study of BaLiF₆:Ce³⁺ as a new active material for tunable UV laser that can be pumped by UV harmonics of available Nd-lasers. This enables all-solid-state tunable UV lasers. In their investigation the crystals were grown in a fluorinating atmosphere using the Bridgeman-Stockbarger technique. In this work we present the results of the growth of BaLiF₆:Ce³⁺ by Czochralski pulling under reactive atmosphere. The compound BaLiF₆ melts incongruently but good optical quality crystal can be obtained if the starting materials for the crystal growth were previously prepared under reactive atmosphere and with the appropriate stoichiometry. This previous synthesis of the compound used in our experiments were realized in the Czochralski furnace under CF₄ atmosphere. High purity commercial fluorides (99.999% grade) were used as starting materials. The results obtained in the Czochralski growth and optical characterization of the grown crystals will be presented.

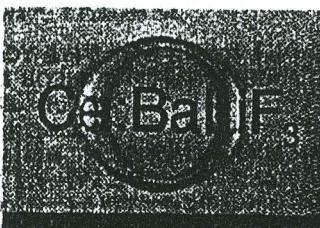


Fig.1 Ce:BaLiF₆ single crystal

1. I.M.A.Dubinskii, K.L.Schepkin, V.V. Semashko, R.Y. Adusabirov, B.M.Galjaudinov, S. L. Korobleva, A. K. Naumov, OSA TOPS Vol.10 Advanced Solid State Lasers (1997), p.30.

permanent address: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/CNEN/SP - Brazil

15p - YN - 14

全固体紫外波長可変レーザー応用 Ce,Na:LiCaAlF₆ 単結晶の作成

Growth of Ce,Na:LiCaAlF₆ single crystals for all-solid-state UV tunable laser applications

東北大・金研・分子研・島村史治・名木原利人・S.L.Baldochi・劉振林・大竹幸幸・猿倉信彦・福田承生
IMR, Tohoku University, IMR, K.Shimamura, Namujilatu, S.L.Baldochi, Z.Liu, H.Ohtake, N.Sarukura, T.Fukuda
E-mail: shimak@lexus.imr.tohoku.ac.jp

【はじめに】紫外レーザーは光情報処理、医用、計測等様々な応用が期待されており、現在これにエキシマレーザーが主に検討されている。しかしながらエキシマレーザーは毒性、不安定性、大型な装置等解決されるべき問題が多い。 Ce 及 Na LiCaAlF_6 (LiCAF)はこれらの問題を解決した全固体波長可変紫外レーザーを実現する材料として注目されている。我々は今回、 $\text{Ce},\text{Na}:\text{LiCAF}$ 単結晶の作成、及び優れたレーザー特性の確認に成功したので報告する。

【実験と結果】単結晶作成は高純度 AlF₃(6N) 空気気下、Cz 法により行った。原料には高純度 AlF₃、LiF と CaF₂粉末(5N)を化学量論組成で混合したもの用いた。格子定数は粉末 X 線回折法、組成分析は ICP, EPMA により行った。引き上速度 1mm/h、結晶回転数 10 rpm の条件でグラウンドのない単結晶が得られた。図 1 に作成した結晶から切り出したウエーハーを示す。結晶外周には不純物が付いていたが、結晶内部は高品質なものであった。格子定数を測定した結果、Ce 濃度の増加に伴い格子定数が上昇する傾向が見られた。組成分析の結果から、Ce の偏析係数は 0.02 を求めた。作成結晶から直径 10mm、長さ 10mm の試料を切り出し、レーザー特性の評価を行った。図 2 に波長 290nm で得られたレーザー特性を示す。従来の高エネルギー発振器では最大 14mJ であったのに対し、今回作成した結晶からスローフ効率が 39%、繰り返し周波数が 10Hz、最大出力 21mJ という従来にない優れた特性が得られた。

Ce:LiCAF

図 1 Ce:Na:LiCAF 単結晶

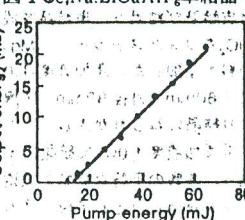


図 2 レーザー入出力特性